

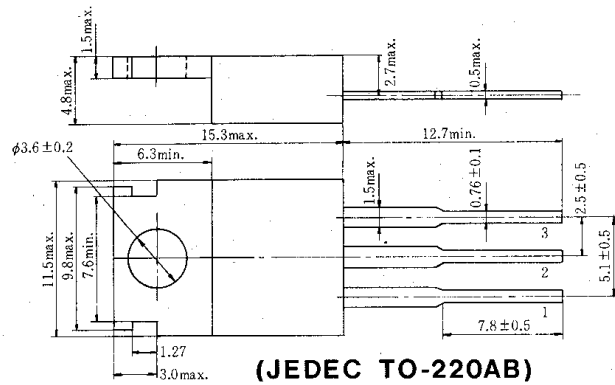
2SB690

シリコン PNP 三重拡散形

低周波電力増幅用
2SD726 とコンプリメンタリペア

SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
Complementary pair with 2SD726



1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
 3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

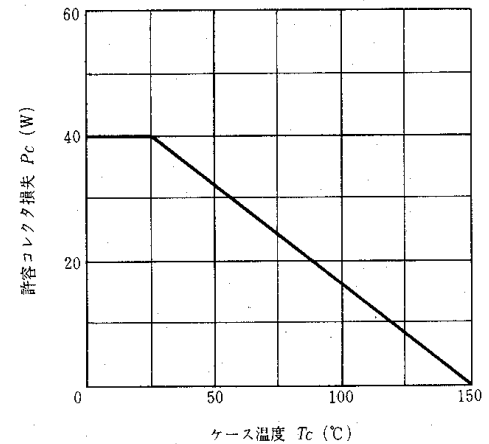
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SB690	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-100	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-4	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	-8	A
許容コレクタ損失	P_C^*	40	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電氣的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-50\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	-80	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-10\mu\text{A}$, $I_C=0$	-5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-80\text{V}$, $I_E=0$	—	—	-0.1	mA
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-1\text{A}$	60	—	200	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-0.1\text{A}$	35	—	—	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-1\text{A}$	—	—	-1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=-2\text{A}$, $I_B=-0.2\text{A}$	—	—	-2	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-0.5\text{A}$	—	20	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-20\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$	—	75	—	pF

* 2SB690 は h_{FE1} の値により下記の様に 2 区分し、現品に表示してあります。

* The 2SB690 is grouped by h_{FE} as follows.

Ⓑ	Ⓒ
60~120	100~200